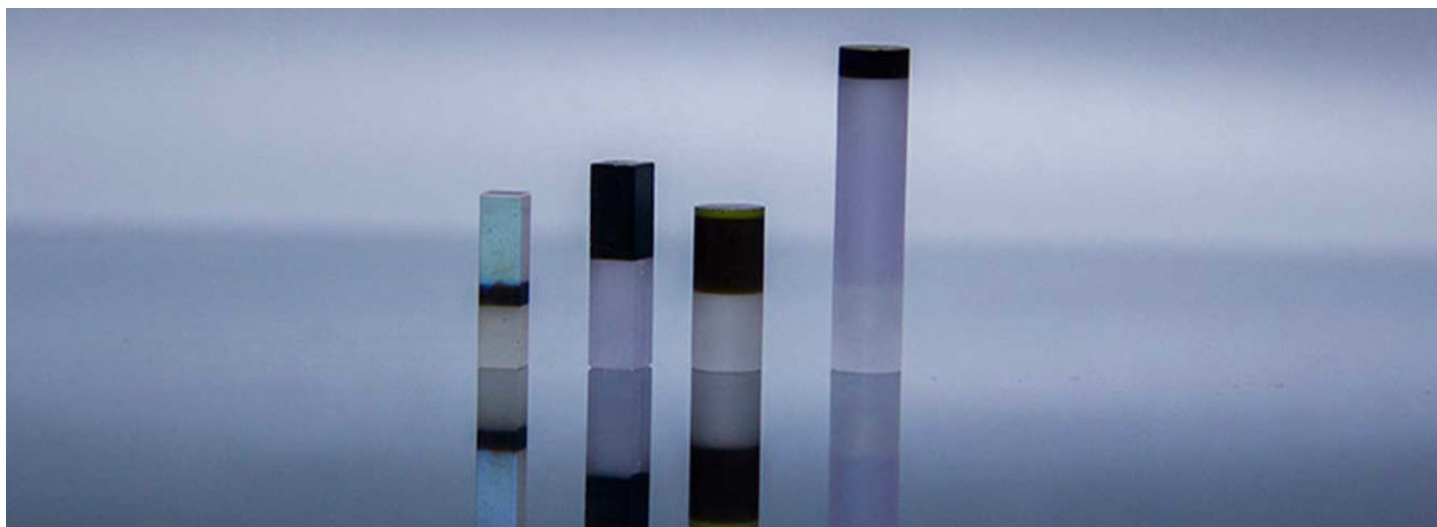


Ti:sapphire+sapphire



描述

我司Ti:sapphire+sapphire键合晶体，是在Ti:sapphire一端键合Sapphire形成的键合晶体，可以有效的改善Ti:sapphire激光的综合性能。

Sapphire晶体的热导率为 $25.12\text{W/m/k}@100^\circ\text{C}$ ，键合形成Ti:sapphire+sapphire键合晶体，可以有效改善Ti:sapphire晶体的热效应，降低激光泵浦时形成的热透镜效应，卓越的输出效率，窄锁模宽度，高损伤阈值，优良的导热性以及改善激光的光束质量，提升800nm激光输出效率，并能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命。

上海芯飞睿使用表面活化键合技术，是一种低温或者常温下的键合技术，典型特征是表面清洗和表面活化。在键合前，通过快原子或者离子束对键合表面的轰击，可以有效的增加键合强度，实现对无机材料、金属、半导体材料间的高质量键合。与高温热键合方法相比，表面活化键合技术键合结合力界面较高、光吸收损耗和面形变化控制相对而言更优，而热扩散键合表面的杂质去不掉，被键合在结合面。表面活化键合技术有去除各种抛光的残留成分、去除有机污染物、去除表面氧化层和打断材料化学键，提升活化能等优点。

生产的Ti:sapphire+sapphire键合晶体的键合强度高、键合面吸收损耗小（一般小于20ppm）、键合面面形变化小（键合后面形 $<\lambda/8$ ）。键合晶体的形状可以是棒状、板状、波导或者三明治形状。在键合晶体两端可以提供多种类型的镀膜，如两个端面增透膜AR@600-800nm&532nm等。Ti:sapphire+sapphire键合晶体广泛应用于波长可调谐激光器中。

特点

- 可以有效改善Ti:sapphire晶体的热效应
- 降低激光泵浦时形成的热透镜效应
- 卓越的输出效率，窄锁模宽度，高损伤阈值
- 优良的导热性以及改善激光的光束质量
- 提升800nm激光输出效率
- 能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命

应用

- 超短脉冲锁模激光器
- 多通放大器和再生放大器



Ti:sapphire+sapphire

参数

Ti:sapphire+Sapphire		
Materials	Ti:sapphire	sapphire
Absorption coefficient	0.6~6.5cm ⁻¹	/
Structure	Rods/Slabs/Sandwich/Waveguide/	
End-face Configuration	Flat/Convex/Wedge	
Side Configuration	Polish/Fine Ground	
Coating available	AR@600-800nm&532nm	AR@600-800nm&532nm
	others	others



有什么问题请联系我们的
技术工程师，在线为
您解答



了解更多资讯，请关注
我们的公众号--上海芯
飞睿科技有限公司

